

製品概要

FDC3535: P チャネル Power Trench® MOSFET、-80 V、-2.1 A、183 mΩ

技術情報は、データシートをご参照ください。

この P チャネル MOSFET は、 $r_{DS(on)}$ 、スイッチング性能、堅牢性のために最適化された高度な PowerTrench® プロセスを使用して製造されています。

特長

- 最大 $r_{DS(on)}$ = 183 mΩ @ $V_{GS} = -10$ V, $I_D = -2.1$ A
- 最大 $r_{DS(on)}$ = 233 mΩ @ $V_{GS} = -4.5$ V, $I_D = -1.9$ A
- 超低 $r_{DS(on)}$ 用の高性能トレンチ技術。
- 広く使われている表面実装パッケージ中の高電力および電流の処理機能
- 高速スイッチング速度。
- UIL 100% テスト済み
- RoHS 対応

アプリケーション

- This product is general usage and suitable for many different applications.

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS}^{(BR)}$ Min (V)	V_{GS}^{Max} (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	I_D^{Max} (A)	P_D^{Max} (W)	$R_{DS(on)}^{n)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5$ V (mΩ)	$R_{DS(on)}^{n)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5$ V (mΩ)	$R_{DS(on)}^{n)}$ Max @ $V_{GS} = 10$ V (mΩ)	Q_g^{Typ} @ $V_{GS} = 4.5$ V (nC)	Q_g^{Typ} @ $V_{GS} = 10$ V (nC)	C_{iss}^{Typ} (pF)	Package Type
FDC3535	0.2467	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	P-Channel	Single	-80	±20	-3	-2.1	1.6	-	233	183	-	6.8	659	TSO T-23-6

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

12/5/2020 作成